日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

17. 6. 2004

REC'D 0 6 AUG 2004

PCT

WIPO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月14日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-354224

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 3 - 3 5 4 2 2 4]

出 願 人
Applicant(s):

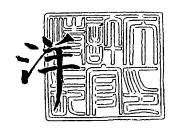
ダイセル化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 7月23日

i) [1]



【書類名】 特許願 【整理番号】 P03DC044 【提出日】 平成15年10月14日 特許庁長官殿 【あて先】 C07B 63/00 【国際特許分類】 【発明者】 兵庫県姫路市勝原区勝原町49-18 【住所又は居所】 【氏名】 蒲原 茂樹 【発明者】 兵庫県加古川市平岡町二俣88-6 【住所又は居所】 岸村 昌明 【氏名】 【特許出願人】 000002901 【識別番号】 【氏名又は名称】 ダイセル化学工業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100101362 【弁理士】 【氏名又は名称】 後藤 幸久 【電話番号】 06-6242-0320 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 053718 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1

9800456

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

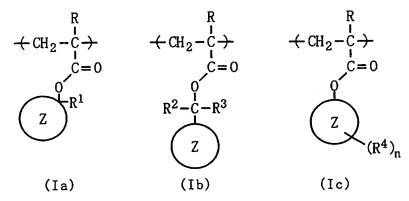
【請求項1】

酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位Aと、極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位Bとを少なくとも含有するフォトレジスト用樹脂であって、重量平均分子量が3000~15000の範囲であり、且つ分子量40000を超えるポリマーの含有率が4重量%以下であることを特徴とするフォトレジスト用樹脂。

【請求項2】

繰り返し単位Aが、下記式(Ia)~(Ic)

【化1】



(式中、環Zは置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim20$ の脂環式炭化水素環を示す。Rは水素原子又は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。 $R^1\sim R^3$ は、同一又は異なって、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。 R^4 は環Zに結合している置換基であって、同一又は異なって、オキソ基、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す。但し、n個の R^4 のうち少なくとも1つは、 $-COOR^a$ 基を示す。前記 R^a は置換基を有していてもよい第3級炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、又はオキセパニル基を示す。nは $1\sim3$ の整数を示す)

から選択された少なくとも1種の繰り返し単位である請求項1記載のフォトレジスト用樹脂。

【請求項3】

繰り返し単位Bが、下記式(IIa)~(IIe)



$$\begin{array}{c} R \\ \downarrow CH_2 - C \\ \downarrow C = 0 \\ C = 0 \\ R^{20} \\ R^{29} \\ R^{28} \\ R^{25} \\ R^{26} \\ 0 \\ (IIe) \end{array}$$

(式中、R は水素原子又は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。 $R^5\sim R^7$ は、同一又は異な って、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で 保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボ キシル基を示し、 $V^1 \sim V^3$ は、同一又は異なって、 $-CH_2-$ 、-CO-又は-COO-を示す。但し、(i) $V^1 \sim V^3$ のうち少なくとも 1 つは - CO - 若しくは - COO - であ るか、又は (ii) $R^5 \sim R^7$ のうち少なくとも1つは、保護基で保護されていてもよいヒド ロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護さ れていてもよいカルボキシル基である。 $R^8 \sim R^{12}$ は、同一又は異なって、水素原子、ア ルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよ いヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す。 R^{13} ~ R²¹は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒド ロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されて いてもよいカルボキシル基を示す。R²²~R³⁰は、同一又は異なって、水素原子、アルキ ル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒ ドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す) から選択された少なくとも1種の繰り返し単位である請求項1又は2記載のフォトレジス

ト用樹脂。 【請求項4】

請求項1~3の何れかの項に記載のフォトレジスト用樹脂と光酸発生剤とを溶媒に溶解して得られるフォトレジスト用樹脂組成物。

【請求項5】

請求項1~3の何れかの項に記載のフォトレジスト用樹脂を溶媒に溶解させる工程を含むフォトレジスト用樹脂組成物の製造法。

【書類名】明細書

【発明の名称】フォトレジスト用樹脂及びフォトレジスト用樹脂組成物

【技術分野】

[0001]

本発明は半導体の微細加工などに用いるフォトレジスト用樹脂組成物を調製する上で有用なフォトレジスト用樹脂、及び該フォトレジスト用樹脂から得られるフォトレジスト用樹脂組成物とその製造法に関する。

【背景技術】

[0002]

半導体製造工程で用いられるポジ型フォトレジストは、光照射により照射部がアルカリ可溶性に変化する性質、シリコンウエハーへの密着性、プラズマエッチング耐性、用いる光に対する透明性等の特性を兼ね備えていなくてはならない。該ポジ型フォトレジストは、一般に、主剤であるポリマーと、光酸化剤と、上記特性を調整するための数種の添加剤を含む溶液として用いられる。一方、半導体の製造に用いられるリングラフィの露光光源は、年々短波長になってきており、次世代の露光光源として、波長193nmのArFエキシマレーザーが有望視されている。このArFエキシマレーザー露光機に用いられるレジスト用ポリマーとして、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位と極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位とを含むポリマーが種々提案されている(例えば、特許文献1,2等)。

[0003]

これらのポリマーは、通常、モノマー混合物を重合した後、重合溶液を沈殿操作に付すことにより単離されている。しかし、こうして得られるポリマーをレジスト用溶剤に溶解させようとすると大部分は溶解するものの、一部不溶分(濁り)が存在する。この不溶分は半導体の製造工程においてトラブルの原因となるため、濾過により除去する必要があるが、粒子が細かいため濾過に多大の時間と労力を要する。

[0004]

【特許文献1】特開2000-26446号公報

【特許文献2】特開平9-73137号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

従って、本発明の目的は、レジスト用溶剤に極めて溶解しやすいフォトレジスト用樹脂、及び該樹脂を溶解させたフォトレジスト用樹脂組成物とその製造法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、(i)ArF用のフォトレジスト用樹脂を滴下重合法により合成し沈殿精製すると、分子量分布が比較的狭く重量平均分子量が3000~15000の範囲にあるポリマーが得られるが、このようなポリマーであってもレジスト用溶剤に溶解させると濁り(不溶分)を生じること、(ii)滴下重合の際、単量体溶液と重合開始剤溶液とを別々の容器から滴下すると、特定分子量(4万)を超えるポリマーの含有率を大幅に低減できること、及び(iii)このようにして得られる特定分子量(4万)を超えるポリマーの含有率が特定値(4重量%)以下である樹脂は、レジスト用溶剤に容易に溶解し、濁りを生じないことを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

[0007]

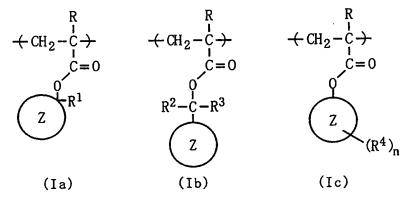
すなわち、本発明は、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位Aと、極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位Bとを少なくとも含有するフォトレジスト用樹脂であって、重量平均分子量が3000~15000範囲であり、且つ分子量40000を超えるポリマーの含有率が4重量%以下であることを特徴とする

フォトレジスト用樹脂を提供する。

[0008]

繰り返し単位Aは、例えば、下記式(Ia)~(Ic)

【化1】



(式中、環Zは置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim20$ の脂環式炭化水素環を示す。Rは水素原子又は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。 $R^1\sim R^3$ は、同一又は異なって、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。 R^4 は環Zに結合している置換基であって、同一又は異なって、オキソ基、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す。但し、n個の R^4 のうち少なくとも1つは、 $-COOR^a$ 基を示す。前記 R^a は置換基を有していてもよい第3級炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、又はオキセパニル基を示す。nは $1\sim3$ の整数を示す)から選択された少なくとも1種の繰り返し単位である。

[0009]

また、繰り返し単位Bは、例えば、下記式 (IIa) ~ (IIe)

$$\begin{array}{c} R \\ + CH_2 - \stackrel{!}{C} + \\ \stackrel{!}{C} = 0 \\ R^{30} \\ R^{29} \\ R^{24} \\ R^{25} \\ R^{26} \\ R^{26} \\ 0 \\ (IIe) \end{array}$$

(式中、R は水素原子又は炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基を示す。 $R^5 \sim R^7$ は、同一又は異な って、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で 保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボ キシル基を示し、 $V^1 \sim V^3$ は、同一又は異なって、 $-CH_2 - CO - V$ は-COO - CO - Vを示す。但し、(i) $V^1 \sim V^3$ のうち少なくとも1つは-CO-若しくは-COO-であ るか、又は (ii) $R^5 \sim R^7$ のうち少なくとも 1 つは、保護基で保護されていてもよいヒド ロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護さ れていてもよいカルボキシル基である。 $R^8 \sim R^{12}$ は、同一又は異なって、水素原子、ア ルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよ いヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す。 R¹³~ R²¹は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒド ロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されて いてもよいカルボキシル基を示す。R²²~R³⁰は、同一又は異なって、水素原子、アルキ ル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒ ドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す) から選択された少なくとも1種の繰り返し単位である。

[0010]

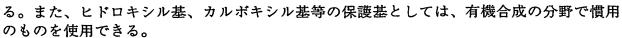
本発明は、また、上記のフォトレジスト用樹脂と光酸発生剤とを溶媒に溶解して得られるフォトレジスト用樹脂組成物を提供する。

[0011]

本発明は、さらに、上記のフォトレジスト用樹脂を溶媒に溶解させる工程を含むフォトレジスト用樹脂組成物の製造法を提供する。

[0012]

なお、本明細書では、「アクリル」と「メタクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイル」等と総称する場合があ



【発明の効果】

[0013]

本発明のフォトレジスト用樹脂によれば、レジスト用の溶剤に対する溶解性が極めて良好であるため、溶剤不溶分の濾過工程を省略又は簡易化でき、フォトレジスト用樹脂組成物を効率よく調製することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

本発明のフォトレジスト用樹脂は、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる 基を含む繰り返し単位Aと、極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位Bとを少なく とも含有している。

[0015]

酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位Aとしては、露光によって光酸発生剤から発生する酸の作用により一部分が脱離してアルカリ現像液に対して可溶性を示すもの(酸脱離性基を有する繰り返し単位)であれば特に限定されず、例えば、炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基を有している(メタ)アクリル酸エステルに対応する繰り返し単位(炭素一炭素二重結合部位で重合した場合の繰り返し単位)などが挙げられる。「炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基を有している(メタ)アクリル酸エステル」には、炭素数6~20の脂環式炭化水素基を有すると共に、(メタ)アクリル酸エステルのエステル結合を構成する酸素原子との結合部位に第3級炭素原子を有する(メタ)アクリル酸エステルのエステル結合を構成する酸素原子と直接結合していてもよく、アルキレン基等の連結基を介して結合していてもよい。前記炭素数6~20の脂環式炭化水素基は単環式炭化水素基であってもよく、多環式(橋かけ環式)炭化水素基であってもよい。このような(メタ)アクリル酸エステルに対応する単位の代表的な例として、前記式(Ia)、(Ib)で表される単位が例示される。

[0016]

また、「炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基 を有している (メタ) アクリル酸エステル」には、炭素数6~20の脂環式炭化水素基を 有すると共に、該脂環式炭化水素基に-COORª基(Rªは置換基を有していてもよい第 3級炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、又はオキセパニル 基を示す)が直接又は連結基を介して結合している(メタ)アクリル酸エステルも含まれ る。-COORª基のRªにおける第3級炭化水素基としては、例えば、tーブチル、tー アミル、2-メチル-2-アダマンチル、(1-メチル-1-アダマンチル)エチル基な どが挙げられる。この第3級炭化水素基が有していてもよい置換基として、例えば、ハロ ゲン原子、アルキル基(例えば、C1-4アルキル基など)、保護基で保護されていてもよ いヒドロキシル基、オキソ基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基などが挙げ られる。また、Raにおけるテトラヒドロフラニル基には2ーテトラヒドロフラニル基が 、テトラヒドロピラニル基には2-テトラヒドロピラニル基が、オキセパニル基には2-オキセパニル基が含まれる。前記連結基としては、アルキレン基(例えば、炭素数1~6 の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基等)などが挙げられる。前記脂環式炭化水素基は、(メタ)アクリル酸エステルのエステル結合を構成する酸素原子と直接結合していてもよく 、アルキレン基等の連結基を介して結合していてもよい。前記炭素数6~20の脂環式炭 化水素基は単環式炭化水素基であってもよく、多環式(橋かけ環式)炭化水素基であって もよい。このような(メタ)アクリル酸エステルに対応する単位の代表的な例として、前 記式(Ic)で表される単位が例示される。

[0017]

また、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位Aとし

て、エステル結合を構成する酸素原子がラクトン環のβ位に結合し且つラクトン環のα位 に少なくとも1つの水素原子を有する、ラクトン環を含む(メタ)アクリル酸エステルに 対応する繰り返し単位(炭素-炭素二重結合部位で重合した場合の繰り返し単位)などを 用いることも可能である。前記繰り返し単位Aは1種のみであってもよく、2種以上の組 み合わせであってもよい。

[0018]

繰り返し単位Aとしては、前記式(Ia)~(Ic)から選択された少なくとも1種の繰り 返し単位であるのが好ましい。式(Ia)~(Ic)中、環Zにおける炭素数 $6\sim20$ の脂環 式炭化水素環は単環であっても、縮合環や橋かけ環等の多環であってもよい。代表的な脂 環式炭化水素環として、例えば、シクロヘキサン環、シクロオクタン環、シクロデカン環 、アダマンタン環、ノルボルナン環、ノルボルネン環、ボルナン環、イソボルナン環、パ ーヒドロインデン環、デカリン環、パーヒドロフルオレン環(トリシクロ〔7.4.0. $0^{3,8}$] トリデカン環)、パーヒドロアントラセン環、トリシクロ $[5.2.1.0^{2,6}]$ デカン環、トリシクロ「 $4.2.2.1^{2,5}$] ウンデカン環、テトラシクロ [4.4.0] $1^{2,5}$ $1^{7,10}$ ドデカン環などが挙げられる。脂環式炭化水素環には、メチル基等の アルキル基(例えば、C1-4アルキル基など)、塩素原子等のハロゲン原子、保護基で保 護されていてもよいヒドロキシル基、オキソ基、保護基で保護されていてもよいカルボキ シル基などの置換基を有していてもよい。環2は例えばアダマンタン環等の多環の脂環式 炭化水素環(橋かけ環式炭化水素環)であるのが好ましい。

[0019]

式 (Ia) \sim (Ic) 中のR、並びに式 (Ia) 、 (Ib) 中のR¹ \sim R³における炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イ ソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ヘキシル基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素1~6 のアルキル基が挙げられる。Rとしては、水素原子又は炭素数1~3のアルキル基が好ま しく、特に水素原子又はメチル基が好ましい。式(Ic)中、R⁴におけるアルキル基とし ては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sープ チル、tーブチル、ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル基などの直鎖状又は分岐鎖状 の炭素1~20程度のアルキル基が挙げられる。R⁴における保護基で保護されていても よいヒドロキシル基としては、例えば、ヒドロキシル基、置換オキシ基(例えば、メトキ シ、エトキシ、プロポキシ基等のC1-4アルコキシ基など)などが挙げられる。保護基で 保護されていてもよいヒドロキシアルキル基としては、前記保護基で保護されていてもよ いヒドロキシル基が炭素数1~6のアルキレン基を介して結合している基などが挙げられ る。保護基で保護されていてもよいカルボキシル基としては、一COOR^b基などが挙げ られる。前記Rbは水素原子又はアルキル基を示し、アルキル基としては、メチル、エチ ル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブチル、ヘキシル 基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~6のアルキル基などが挙げられる。R4におい て、-COOR^a基のR^aは前記と同様である。

前記極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位Bには、(1)ラクトン環を含有す る炭素数6~20の脂環式炭化水素基[ラクトン環と単環又は多環(橋かけ環)の脂環式 炭素環とが縮合した構造を有する基等] がエステル結合を構成する酸素原子に結合してい る (メタ) アクリル酸エステルに対応するモノマー単位B1 (炭素ー炭素二重結合部位で重 合した場合の繰り返し単位)が含まれる。このような繰り返し単位B1の代表的な例として 、前記式(IIa)のうち $V^1 \sim V^3$ の少なくとも1つが-COO-である単位、及び(IIb)、(IIc)、(IId)、(IIe)で表される単位が例示される。

[0021]

また、極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位Bには、(2)ヒドロキシル基、 カルボキシル基、オキソ基などの極性基を有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基(特 に、橋かけ環式炭化水素基)がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ) アクリル酸エステルに対応するモノマー単位B2 (炭素-炭素二重結合部位で重合した場合

の繰り返し単位) も含まれる。このような繰り返し単位B2の代表的な例として、前記式(IIa) のうち $V^1 \sim V^3$ の少なくとも1つが-CO-であるか、又は $R^5 \sim R^7$ のうち少なく とも1つが、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていても よいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボキシル基である単 位が例示される。

[0022]

繰り返し単位Bは、極性基によりシリコンウエハーなどの基板に対する密着性を付与す ると共に、脂環式骨格によりドライエッチング耐性を付与する。繰り返し単位 Bは 1種の みであってもよく、2種以上の組み合わせであってもよい。繰り返し単位Bとしては、前 記式(IIa)~(IIe)から選択された少なくとも1種の繰り返し単位であるのが好まし い。また、繰り返し単位Bとして繰り返し単位B1と繰り返し単位B2とを組み合わせると、 基板密着性、ドライエッチング耐性、レジスト溶剤に対する溶解性等の特性をバランスよ く具備するだけでなく、重合時における均質反応性にも優れる(分子量や分子構造におい て均一性の高いポリマーが生成する)という大きな利点が得られる。

[0023]

式 (II a) ~ (II e) 中のRは前記 (Ia) ~ (Ic) 中のRと同様である。式 (II a) ~ (IIe)中、 $R^5 \sim R^{30}$ におけるアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソ プロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル、デシル 、ドデシル基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~13のアルキル基等が挙げられる。 これらの中でも、炭素数1~4のアルキル基が好ましい。保護基で保護されていてもよい ヒドロキシル基としては、例えば、ヒドロキシル基、置換オキシ基(例えば、メトキシ、 エトキシ、プロポキシ基等のC1-4アルコキシ基など)などが挙げられる。保護基で保護 されていてもよいヒドロキシアルキル基としては、前記保護基で保護されていてもよいヒ ドロキシル基が炭素数1~6のアルキレン基を介して結合している基などが挙げられる。 保護基で保護されていてもよいカルボキシル基としては、一COORb基などが挙げられ る。Rbは前記と同様である。

[0024]

本発明のフォトレジスト用樹脂は、アルカリ可溶性(酸脱離性)、基板密着性、ドライ エッチング耐性、レジスト溶剤への溶解性などの特性を損なわない範囲で、前記繰り返し 単位A及びB以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。このような繰り返し単位としては 、繰り返し単位Aに対応する単量体及び繰り返し単位Bに対応する単量体と共重合可能な 単量体に対応する単位であって、且つレジスト特性を損なわないようなものであれば特に 限定されない。例えば、(メタ)アクリル酸又はその誘導体、マレイン酸又はその誘導体 、フマル酸又はその誘導体、環状オレフィン類などに対応する単位が挙げられる。前記(メタ) アクリル酸又はその誘導体としては、例えば、α-(メタ) アクリロイルオキシー $-\gamma$ - γ トン、 α - (メ ϕ) アクリロイルオキシー γ , γ - \vec{y} メチルー γ - \vec{y} チロラクトン等の、 ラクトン環(γーブチロラクトン環、δーバレロラクトン環など)を有する(メタ)アク リル酸エステルなどが挙げられる。このラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル は、ポリマーに基板密着性を付与しうる。

[0025]

本発明のフォトレジスト用樹脂における前記繰り返し単位Aの含有量は、例えば5~9 0 モル%、好ましくは $10 \sim 80$ モル%、さらに好ましくは $20 \sim 70$ モル%である。繰 り返し単位Aの含有量が5モル%未満の場合には、アルカリ現像の際のレジスト膜の溶解 性が不十分となり、解像度が低下し、微細なパターンを精度よく形成することが困難とな る。また、繰り返し単位Aの含有量が90モル%を超える場合には、基板密着性やドライ エッチング耐性が低下し、現像によりパターンが剥がれて残らないという問題が起こりや すい。

[.0026]

本発明のフォトレジスト用樹脂における前記繰り返し単位Bの含有量は、例えば10~ 出証特2004-3064722

95モル%、好ましくは20~90モル%、さらに好ましくは30~80モル%である。 繰り返し単位Bの含有量が10モル%未満の場合には基板密着性やドライエッチング耐性 が低下しやすくなり、95モル%を超えるとアルカリ可溶性単位の導入量が少なくなるこ とから、アルカリ現像の際のレジスト膜の溶解性が不十分になりやすい。繰り返し単位B として繰り返し単位B1と繰り返し単位B2とを組み合わせる場合、両者の割合は特に限定さ れないが、一般には前者/後者(モル比)=5/95~95/5、好ましくは10/90 ~90/10、さらに好ましくは30/70~70/30程度である。

[0027]

本発明のフォトレジスト用樹脂の重要な特徴は、重量平均分子量(Mw)が3000~ 15000の範囲であり、且つ分子量40000を超えるポリマーの含有率がポリマー全 体の4重量%以下(好ましくは3重量%以下、さらに好ましくは2重量%以下)である点 にある。重量平均分子量が3000未満ではレジスト膜を形成する際に所望の塗膜強度が 得られない。重量平均分子量が15000を超えるとフォトレジスト用樹脂組成物を調製 する際に溶液粘度が高くなり、作業性が低下すると共に、均質で良好な塗膜が得られない 。重量平均分子量は、好ましくは4000~14000であり、さらに好ましくは500 0~13000程度である。分子量40000を超えるポリマーの含有率が4重量%を超 えると、レジスト溶剤に溶解させる際に不溶分(濁り)を生じる。フォトレジスト用樹脂 中にレジスト溶剤に溶解しにくい成分が存在すると、均一且つ均質なレジスト膜が得られ ず、感度や解像度が低下し、所望のパターンを精度よく得ることが困難になる。このため 、不溶分の濾過操作が必要となるが、前記不溶分は一般に微粒子(コロイド状)であるた め、濾過に多大な時間と労力がかかり、フォトレジスト用樹脂組成物の効率的な生産が阻 まれることになる。本発明のフォトレジスト用樹脂の分子量分布(Mw/Mn)は、例え ば1. 1~3. 5、好ましくは1. 5~3. 0程度である。なお、前記Mnは数平均分子 量を示し、Mn、Mwともにポリスチレン換算の値である。樹脂の重量平均分子量、分子 量40000を超えるポリマーの含有率、分子量分布はGPC(ゲルパーミエーションク ロマトグラフィー)により測定できる。

[0028]

本発明のフォトレジスト用樹脂は、例えば、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶 性となる基を含む単量体aと極性基を有する脂環式骨格を含む単量体bとを少なくとも含 む単量体混合物を含有する単量体溶液と、重合開始剤を含有する重合開始剤溶液とを、別 々の容器から並行して反応容器内に滴下しながら、60~130℃の温度で重合させるこ とにより製造することができる。

[0029]

この際、単量体溶液と重合開始剤溶液とを別々の容器から別個に反応容器内に滴下する ことが重要である。このような操作を行うことにより、分子量40000を超えるポリマ ーの含有率をポリマー全体の4重量%以下にすることが可能となる。これに対し、単量体 と重合開始剤の両者を含有する溶液を反応容器内に滴下する場合には、滴下用容器内で未 滴下の単量体の重合が少しずつ進行して分子量の高いポリマーが生成するため、重合終了 後に得られるポリマーにおいて、分子量40000を超える高分子量のポリマーがポリマ -全体の4重量%を超えることになる。

[0030]

また、上記の滴下重合法において、重合温度(反応液温)の振れ幅を極力小さくするよ うに温度制御することが望ましい。例えば、単量体溶液と重合開始剤溶液の全滴下時間の 93%以上の間(好ましくは95%以上の間)、重合温度(反応液温)を設定温度に対し て±5℃以内(好ましくは±3℃以内)に制御することが好ましい。全滴下時間の7%以 上の間、重合温度が設定温度に対して±5℃の範囲を逸脱する状態(重合温度の振れ幅が ± 5 %を超える状態)で重合を行うと、分子量 4 0 0 0 0 を超えるポリマーの含有率が増 大しやすい。特に滴下初期においては、滴下する溶液が通常常温付近であり、しかも滴下 開始時には重合熱の発生量も少ないことから、重合温度(反応液温)が制御系の設定温度 よりも一旦大きく低下して、重合温度の振れ幅が大きくなる場合が多い。このことから、

重合温度を上記のように小さな振れ幅で制御する方法として、単量体溶液及び重合開始剤溶液の滴下前の反応容器内の温度(液温)を設定温度よりも高い温度[例えば、(設定温度+1℃)~(設定温度+5℃)、好ましくは(設定温度+1℃)~(設定温度+3℃)]に調整しておいて滴下を開始する方法が挙げられる。この方法によれば、単量体溶液と重合開始剤溶液の滴下が開始されると系内温度が下がり始め、目的の設定温度付近になったところで制御系の設定温度を徐々に該目的の設定温度にまで下げることにより、系内温度は該設定温度より大きく下がることなく、短時間内に該設定温度で安定させることが可能となる。その結果、分子量40000を超える高分子量のポリマーの生成を抑制できる。これに対して、滴下開始時に、反応容器内の温度を目的の設定温度に調整しており場合には、滴下開始と共に系内の温度が設定温度より下がり、それをカバーするために制御系は大きく加熱側に傾き、温度のハンチングが大きくなり、全滴下時間の7%以上の間(何えば30分以上の間)、重合温度が設定温度に対して±5℃の範囲を逸脱する状態(重合温度の振れ幅が±5%を超える状態)で重合が行われることになる。その結果、分子量40000を超える高分子量のポリマーの含有率が増大してポリマー全体の4重量%を超えるに至る。

[0031]

なお、滴下時間の93%以上の間、重合温度を設定温度に対して±5℃以内に制御する方法としては、上記の方法に限らず、他の方法を採用することもできる。例えば、単量体溶液及び重合開始剤溶液の滴下速度を最初は小さくしておき、その後滴下速度を大きくすることにより、系内の温度の変動を抑えることもできる。

[0032]

滴下重合は、より具体的には、例えば、単量体混合物を有機溶媒(重合溶媒)に溶解した単量体溶液と、重合開始剤を有機溶媒(重合溶媒)に溶解した重合開始剤溶液とをそれぞれ調製して別々の容器に入れ、所定の温度に調整した有機溶媒(重合溶媒)中に前記単量体溶液と重合開始剤溶液とを各々並行して滴下することにより行われる。単量体溶液と重合開始剤溶液は同じ速度で滴下するのが好ましい。

[0033]

重合溶媒としては、例えば、グリコール系溶媒、エステル系溶媒、ケトン系溶媒、エー テル系溶媒、アミド系溶媒、スルホキシド系溶媒、1価アルコール系溶媒、炭化水素系溶 媒、これらの混合溶媒などが挙げられる。グリコール系溶媒には、例えば、プロピレング リコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなど のプロピレングリコール系溶媒;エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリ コールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレ ングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、 エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートなどのエチレングリコール系溶媒など が含まれる。エステル系溶媒には、乳酸エチルなどの乳酸エステル系溶媒;3-メトキシ プロピオン酸メチルなどのプロピオン酸エステル系溶媒;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 プロピル、酢酸ブチルなどの酢酸エステル系溶媒などが挙げられる。ケトン系溶媒には、 アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン、シクロ ヘキサノンなどが含まれる。エーテル系溶媒には、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエ ーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどが含まれる。アミド系 溶媒には、N,N-ジメチルホルムアミドなどが含まれる。スルホキシド系溶媒には、ジ メチルスルホキシドなどが含まれる。1価アルコール系溶媒には、メタノール、エタノー ル、プロパノール、ブタノールなどが含まれる。炭化水素系溶媒には、トルエン、キシレ ン、ヘキサン、シクロヘキサンなどが含まれる。

[0034]

好ましい重合溶媒には、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのグリコール系溶媒、乳酸エチルなどのエステル系溶媒、メチルイソプチルケトン、メチルアミルケトンなどのケトン系溶媒及びこれらの混合溶媒が含まれる。特に、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート単独溶

媒、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートとプロピレングリコールモノメ チルエーテルとの混合溶媒、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートと乳酸 エチルとの混合溶媒などの、少なくともプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ ートを含む溶媒が好ましい。

[0035]

重合開始剤として公知の重合開始剤を使用できる。

[0036]

滴下重合において、予め仕込まれる溶媒の量と滴下する溶液(単量体溶液、重合開始剤 溶液)の総量との比率は、生産性や経済性、作業性、操作性等を考慮しつつ、樹脂の品質 を損なわない範囲で適宜設定できるが、一般には、前者/後者(重量比)=5/95~9 0/10、好ましくは10/90~70/30、さらに好ましくは20/80~60/40の範囲である。使用する重合溶媒の総量(予め仕込まれる溶媒又は溶液中の溶媒の量+ 滴下する溶液中の溶媒の量)は、作業性、操作性、反応効率、生成するポリマーの溶解性 等を考慮して適宜選択できるが、単量体の総量100重量部に対して、一般には100~ 2000重量部、好ましくは200~1000重量部、さらに好ましくは300~700 重量部程度である。

[0037]

単量体溶液及び重合開始剤溶液の全滴下時間は、重合温度及び単量体の種類等によって 異なるが、一般には1~10時間、好ましくは3~8時間程度である。重合温度は単量体 溶液又は重合開始剤溶液の滴下操作の前半(全滴下時間の1/2まで)において特に制御 しにくく、温度の振れ幅が大きくなりやすい。従って、単量体溶液又は重合開始剤溶液の 滴下操作における前半の滴下時間の95%以上の間、重合温度を設定温度に対して±5℃ 以内(好ましくは±3℃以内)に制御するのが特に好ましい。なお、滴下終了後、適宜な 時間(例えば0.1~10時間、好ましくは1~6時間程度)、適宜な温度(例えば60 ~130℃)下で熟成して重合を完結させてもよい。

[0038]

前記単量体aは繰り返し単位Aに対応し、単量体bは繰り返し単位Bに対応する。前記 式 (Ia) ~ (Ic) 、 (IIa) ~ (IIe) で表される各繰り返し単位を含む樹脂は、それぞれ 対応する(メタ)アクリル酸エステルをコモノマーとして重合に付すことにより製造でき る。

[0039]

[式 (Ia) ~ (Ic) で表される繰り返し単位]

前記式 (Ia) ~ (Ic) で表される繰り返し単位に対応するモノマーは、それぞれ下記式 (1a) ~ (1c) で表される。式 (1a) ~ (1c) で表される化合物には、それぞれ立体異性 体が存在しうるが、それらは単独で又は2種以上の混合物として使用できる。

[0040]【化3】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $CH_2 = C$
 $CH_2 = C$

(式中、環2は置換基を有していてもよい炭素数6~20の脂環式炭化水素環を示す。R は水素原子又はメチル基を示す。 $R^1 \sim R^3$ は、同一又は異なって、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキ ル基を示す。R⁴は環乙に結合している置換基であって、同一又は異なって、オキソ基、

アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す。但し、n個のR⁴のうち少なくとも1つは、-COOR^a基を示す。前記R^aは置換基を有していてもよい第3級炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、又はオキセパニル基を示す。nは1~3の整数を示す)

[0041]

式 (1a) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[1-1] 2 - (メタ) アクリロイルオキシー 2 - メチルアダマンタン (R=H又はCH₃、 R^1 =CH₃、Z=アダマンタン環)

[1-2] 1-ヒドロキシー 2- (メタ) アクリロイルオキシー 2-メチルアダマンタン (R=H又はCH₃、 R^1 =CH₃、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-3] 5-ヒドロキシー2-(メタ) アクリロイルオキシー $2-メチルアダマンタン(R=H又はCH₃、<math>R^1=CH_3$ 、Z=5位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-4] 1,3-ジヒドロキシー2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチルアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^1=CH_3$ 、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-5] 1,5ージヒドロキシー2ー (メタ) アクリロイルオキシー2ーメチルアダマンタン ($R = H Z L C H_3$ 、 $R^1 = C H_3$ 、Z = 1 位と5 位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-6] 1,3-ジヒドロキシー6-(メタ) アクリロイルオキシー6-メチルアダマンタン ($R = H 又は C H_3$ 、 $R^1 = C H_3$ 、Z = 1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-7] 2- (メタ) アクリロイルオキシー2-エチルアダマンタン (R=H又はCH₃、 R^1 =CH₂CH₃、Z=アダマンタン環)

[1-8] 1-ヒドロキシー 2- (メタ) アクリロイルオキシー 2-エチルアダマンタン (R=H又はCH₃、R¹=CH₂CH₃、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-9] 5-ヒドロキシ-2-(メタ) アクリロイルオキシー $2-エチルアダマンタン(R=H又はCH₃、<math>R^1=CH_2CH_3$ 、Z=5位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-10] 1,3ージヒドロキシー2ー(メタ) アクリロイルオキシー2ーエチルアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^1=CH_2CH_3$ 、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-11] 1,5-ジヒドロキシー2-(メタ) アクリロイルオキシー2-エチルアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^1=CH_2CH_3$ 、Z=1位と5位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-12] 1,3-ジヒドロキシー6-(メタ) アクリロイルオキシー6-エチルアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^1=CH_2CH_3$ 、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[0042]

上記式 (1a) で表される化合物は、例えば、対応する環式アルコールと (メタ) アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0043]

式 (1b) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[1-13] 1- (1-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルエチル) アダマンタン (R=H又はCH₃、 $R^2=R^3=CH_3$ 、Z=アダマンタン環)

アダマンタン (R=H又はCH₃、R²=R³=CH₃、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-15] $1-(1-x + \nu - 1 - (メ タ) アクリロイルオキシプロピル) アダマンタン (R=H又はCH₃、<math>R^2=R^3=CH_2CH_3$ 、Z=rダマンタン環)

[1-16] 1-ヒドロキシ-3-(1-エチル-1-(メタ)アクリロイルオキシプロピル)アダマンタン(R=H又は CH_3 、 $R^2=R^3=CH_2CH_3$ 、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-17] 1-(1-(メタ)) アクリロイルオキシー1-メチルプロピル) アダマンタン (R=H又はCH₃、R²=CH₃、R³=CH₂CH₃、Z=アダマンタン環)

[1-18] 1-ヒドロキシー3- (1- (メタ) アクリロイルオキシー1-メチルプロピル) アダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^2=CH_3$ 、 $R^3=CH_2$ CH_3 、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-19] 1-(1-(メタ)) アクリロイルオキシー1, 2-ジメチルプロピル) アダマンタン $(R=H又はCH₃、<math>R^2=CH₃$ 、 $R^3=CH(CH₃)₂、<math>Z=アダマンタン環)$

[1-20] $1-ヒドロキシ-3-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1, 2-ジメチルプロピル) アダマンタン (R=H又はCH₃、<math>R^2=CH_3$ 、 $R^3=CH$ (CH₃) $_2$ 、Z=1位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-21] 1, 3-ジヒドロキシー5-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルエチル) アダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^2=R^3=CH_3$ 、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-22] 1-(1-x+y-1-(y+y)) アクリロイルオキシプロピル) -3, 5-y+y-1 ドロキシアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^2=R^3=CH_2CH_3$ 、Z=3位と 5位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-23] 1, 3-ジヒドロキシー5-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルプロピル) アダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^2=CH_3$ 、 $R^3=CH_2$ CH_3 、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[1-24] 1, 3-ジヒドロキシー5- (1-(メタ) アクリロイルオキシー1, 2-ジメチルプロピル) アダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^2=CH_3$ 、 $R^3=CH$ (CH_3) 2、Z=1位と3位にヒドロキシル基を有するアダマンタン環)

[0044]

上記式 (1b) で表される化合物は、例えば、対応する1位に脂環式基を有するメタノール誘導体と (メタ) アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0045]

式 (1c) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[1-25] 1-t-プトキシカルボニル-3-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン(R=H又は CH_3 、 $R^4=t-プトキシカルボニル基、<math>n=1$ 、Z=アダマンタン環)

[1-26] 1, 3-ビス(t-ブトキシカルボニル)-5-(メタ)アクリロイルオキシア ダマンタン [R=H又は CH_3 、 $R^4=t-$ ブトキシカルボニル基、n=2、Z=アダマンタン環]

[1-27] 1-t- プトキシカルボニルー3-ヒドロキシー5-(メタ)アクリロイルオキシアダマンタン(R=H又は CH_3 、 $R^4=OH$, t-ブトキシカルボニル基、n=2、Z=アダマンタン環)

[1-28] 1-(2-r) ラヒドロピラニルオキシカルボニル) -3-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^4=2-r$) トラヒドロピラニルオキシカルボニル基、n=1、Z=rダマンタン環)

[1-29] 1, $3-ビス(2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル)-5-(メタ)アクリロイルオキシアダマンタン(R=H又は<math>CH_3$ 、 $R^4=2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基、<math>n=2$ 、Z=アダマンタン環)

[1-30] 1-ヒドロキシー3-(2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル)-5-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン(<math>R=H又は CH_3 、 $R^4=OH$, 2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基、<math>n=2、Z=アダマンタン環)

[0046]

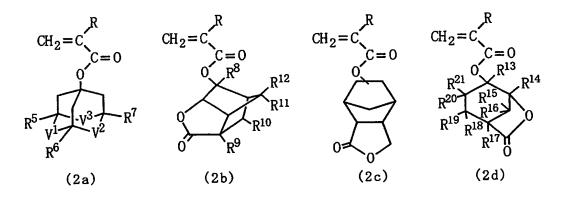
上記式 (1c) で表される化合物は、例えば、対応する環式アルコールと(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0047]

[式 (II a) ~ (II e) で表される繰り返し単位]

前記式 (II a) \sim (II e) で表される繰り返し単位に対応するモノマーは、それぞれ下記式 (2a) \sim (2e) で表される。式 (2a) \sim (2e) で表される化合物には、それぞれ立体異性体が存在しうるが、それらは単独で又は 2 種以上の混合物として使用できる。

【0048】



$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{C} = \text{O} \\ \text{R}^{20} \\ \text{R}^{29} \\ \text{R}^{25} \\ \text{R}^{28} \\ \text{R}^{27} \\ \text{O} \\ \text{(2e)} \end{array}$$

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示す。 $R^5 \sim R^7$ は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示し、 $V^1 \sim V^3$ は、同一又は異なって、 $-CH_2-$ 、-CO-又は-COO-を示す。但し、(i) $V^1 \sim V^3$ のうち少なくとも1つは-CO-若しくは-COO-であるか、又は(ii) $R^5 \sim R^7$ のうち少なくとも1つは、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、又は保護基で保護されていてもよいカルボキシル基である。 $R^8 \sim R^{12}$ は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボ



キシル基を示す。 $R^{22} \sim R^{30}$ は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基を示す)

[0049]

式 (2a) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-1] 1-(メタ) アクリロイルオキシー4-オキサトリシクロ [4.3.1. $1^{3,8}$] ウンデカン-5-オン(R=H又は CH_3 、 $R^5=R^6=R^7=H$ 、 $V^2=-CO-O-$ (左側が R^6 の結合している炭素原子側)、 $V^1=V^3=-CH_2-$)

[2-2] 1-(メタ) アクリロイルオキシー4, 7-ジオキサトリシクロ $[4.4.1.1]^{3,9}$] ドデカンー5, 8-ジオン(R=H又は CH_3 、 $R^5=R^6=R^7=H$ 、 $V^1=-CO-O-$ (左側が R^5 の結合している炭素原子側)、 $V^2=-CO-O-$ (左側が R^6 の結合している炭素原子側)、 $V^3=-CH_2-$)

[2-3] 1-(メタ) アクリロイルオキシー4, 8-ジオキサトリシクロ $[4.4.1.1^{3.9}]$ ドデカン-5, 7-ジオン $(R=H又はCH_3, R^5=R^6=R^7=H, V^1=-O-CO-($ 左側が R^5 の結合している炭素原子側)、 $V^2=-CO-O-($ 左側が R^6 の結合している炭素原子側)、 $V^3=-CH_2-)$

[2-4] 1-(メタ) アクリロイルオキシー5, 7-ジオキサトリシクロ [4.4.1. $1^{3,9}$] ドデカンー4, 8-ジオン(R=H又は CH_3 、 $R^5=R^6=R^7=H$ 、 $V^1=-CO-O-$ (左側が R^5 の結合している炭素原子側)、 $V^2=-O-CO-$ (左側が R^6 の結合している炭素原子側)、 $V^3=-CH_2-$)

[2-5] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン(R=H又はC H_3 、 $R^5=OH$ 、 $R^6=R^7=H$ 、 $V^1=V^2=V^3=-CH_2-)$

[2-6] 1-(メタ) アクリロイルオキシー3, 5-ジヒドロキシアダマンタン(R=H 又は CH_3 、 $R^5=R^6=OH$ 、 $R^7=H$ 、 $V^1=V^2=V^3=-CH_2-)$

[2-8] 1-(x + y) y = y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0 y = 0

[2-9] 1-(メタ) アクリロイルオキシー3-カルボキシアダマンタン (R=H又はCH $_3$ 、R $^5=$ COOH、R $^6=$ R $^7=$ H、V $^1=$ V $^2=$ V $^3=$ -CH $_2-$)

[0050]

上記式 (2a) で表される化合物は、対応する環式アルコール誘導体と(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0051]

式 (2b) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[2-10] 5-(メタ) アクリロイルオキシー3-オキサトリシクロ $[4.\ 2.\ 1.\ 0^{4.8}]$ ノナン-2-オン (=5-(メタ) アクリロイルオキシー2, 6-ノルボルナンカルボラクトン) $(R=H又はCH_3, R^8=R^9=R^{10}=R^{11}=R^{12}=H)$

[2-11] 5- (メタ) アクリロイルオキシ-5-メチル-3-オキサトリシクロ [4.2.1.0^{4,8}] ノナン-2-オン (R=H又はCH₃、R⁸=CH₃、R⁹=R¹⁰=R¹¹=R¹²=H)

[2-12] 5 - (メタ) アクリロイルオキシー1-メチルー3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. $0^{4.8}$] ノナンー2-オン(R=H又はCH₃、R⁹=CH₃、R⁸=R¹⁰=R¹¹=R¹ = H)

[2-13] 5-(メタ) アクリロイルオキシー9-メチル-3-オキサトリシクロ [4.2.1.0^{4,8}] ノナンー<math>2-オン (R=H又はCH₃、R¹⁰=CH₃、R⁸=R⁹=R¹¹=R¹²=H)

[2-14] 5- (メタ) アクリロイルオキシー 9 - カルボキシー 3 - オキサトリシクロ [4 . 2 . 1 . $0^{4\cdot8}$] ノナンー 2 - オン(R=H又はCH₃、R⁸=R⁹=R¹¹=R¹²=H、R 10 =COOH)

[2-15] 5-(メタ) アクリロイルオキシー9-メトキシカルボニルー3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. $0^{4,8}$] ノナンー2-オン(R=H又はCH₃、R⁸=R⁹=R¹¹=R¹²=H、R¹⁰=メトキシカルボニル基)

[2-16] 5-(メタ) アクリロイルオキシー9-エトキシカルボニルー3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. $0^{4.8}$] ノナンー2-オン(R=H又は CH_3 、 $R^8=R^9=R^{11}=R^{12}=H$ 、 $R^{10}=$ エトキシカルボニル基)

[2-17] 5-(メタ) アクリロイルオキシー9-t-プトキシカルボニルー3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. $0^{4.8}$] ノナンー2-オン(R=H又はCH₃、R⁸=R⁹=R¹¹=R¹²=H、R¹⁰=t-ブトキシカルボニル基)

$[0\ 0\ 5\ 2]$

上記式 (2b) で表される化合物は、対応する環式アルコール誘導体と(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って、反応させることにより得ることができる。なお、その際に原料として用いる環式アルコール誘導体は、例えば、対応する5ーノルボルネンー2ーカルボン酸誘導体又はそのエステルを過酸(過酢酸、mークロロ過安息香酸など)又は過酸化物(過酸化水素、過酸化水素+酸化タングステンやタングステン酸などの金属化合物)と反応(エポキシ化及び環化反応)させることにより得ることができる。

[0053]

式 (2c) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-18] 8-(メタ) アクリロイルオキシー4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. $0^{2,6}$] デカン-5-オン (R=H又は CH_3)

[2-19] 9-(メタ) アクリロイルオキシー4-オキサトリシクロ $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$ デカンー5-オン (R=H又は $CH_3)$

[0054]

上記式 (2c) で表される化合物は、対応する環式アルコール誘導体と (メタ) アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0055]

式 (2d) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-20] 4-(メタ) アクリロイルオキシー6-オキサビシクロ [3.2.1] オクタン -7-オン $(R=H又はCH₃、<math>R^{13}=R^{14}=R^{15}=R^{16}=R^{17}=R^{18}=R^{19}=R^{20}=R^{2}$ $^{1}=H$)

[2-21] 4-(メタ) アクリロイルオキシー4-メチルー6-オキサビシクロ [3. 2. 1] オクタンー7-オン (R=H又はCH₃、R¹⁴=R¹⁵=R¹⁶=R¹⁷=R¹⁸=R¹⁹=R² = R²¹=H、R¹³=CH₃)

[2-22] 4-(メタ) アクリロイルオキシー5-メチルー6-オキサビシクロ [3. 2. 1] オクタンー7-オン (R=H又はCH₃、R¹³=R¹⁵=R¹⁶=R¹⁷=R¹⁸=R¹⁹=R²0=R²¹=H、R¹⁴=CH₃)

[0056]

式 (2e) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[2-24] 6-(メタ) アクリロイルオキシー2-オキサビシクロ[2.2.2] オクタン

-3-オン (R=H又はCH₃、R²²=R²³=R²⁴=R²⁵=R²⁶=R²⁷=R²⁸=R²⁹=R³0=H)

[2-25] 6-(メタ) アクリロイルオキシー6-メチル-2-オキサビシクロ [2. 2. 2] オクタン-3-オン (R=H又はCH₃、R²²=R²⁴=R²⁵=R²⁶=R²⁷=R²⁸=R² = R³⁰=H、R²³=CH₃)

[2-26] 6-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルー2-オキサビシクロ [2. 2. 2] オクタンー3-オン (R=H又はCH₃、R²³=R²⁴=R²⁵=R²⁶=R²⁷=R²⁸=R² = R³⁰=H、R²²=CH₃)

[2-27] 6-(メタ)アクリロイルオキシー1,6-ジメチルー2-オキサビシクロ [2.2.2] オクタンー3-オン(R=H又はCH₃、R²⁴=R²⁵=R²⁶=R²⁷=R²⁸=R² = R³⁰=H、R²²=R²³=CH₃)

[0057]

上記式 (2d) 及び (2e) で表される化合物は、対応する環式アルコール誘導体と (メタ) アクリル酸又はその反応性誘導体とを、酸触媒やエステル交換触媒を用いた慣用のエステル化法に従って反応させることにより得ることができる。

[0058]

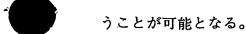
重合により得られたポリマーは沈殿又は再沈殿により単離できる。例えば、重合溶液(ポリマードープ)を溶媒(沈殿溶媒)中に添加してポリマーを沈殿させるか、又は該ポリ マーを再度適当な溶媒に溶解させ、この溶液を溶媒(再沈殿溶媒)中に添加して再沈殿さ せることにより目的のポリマーを得ることができる。沈殿又は再沈殿溶媒は有機溶媒及び 水の何れであってもよく、また混合溶媒であってもよい。沈殿又は再沈殿溶媒として用い る有機溶媒として、例えば、炭化水素(ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの 脂肪族炭化水素;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ベンゼ ン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、 クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベンゼン、ジクロロ ベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素など)、ニトロ化合物(ニトロメタン、ニトロ エタンなど)、ニトリル(アセトニトリル、ベンゾニトリルなど)、エーテル(ジエチル エーテル、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エーテル;テトラヒド ロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケトン(アセトン、メチルエチルケトン、 ジイソブチルケトンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、カーボネート(ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチレンカーボネート、プロピレンカー ボネートなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルア ルコール、ブタノールなど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒を含む混合溶媒等 が挙げられる。

[0059]

中でも、前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、少なくとも炭化水素(特に、ヘキサンやヘプタンなどの脂肪族炭化水素)を含む溶媒が好ましい。このような少なくとも炭化水素を含む溶媒において、炭化水素(例えば、ヘキサンやヘプタンなどの脂肪族炭化水素)と他の溶媒(例えば、酢酸エチルなどのエステル類等)との比率は、例えば前者/後者(体積比;25°C)= $10/90\sim99/1$ 、好ましくは前者/後者(体積比;25°C)= $30/70\sim98/2$ 、さらに好ましくは前者/後者(体積比;25°C)= $50/50\sim97/3$ 程度である。

[0060]

沈殿又は再沈殿で得られたポリマーは、必要に応じて、リパルプ処理やリンス処理に付される。リパルプ処理後にリンス処理を施してもよい。重合により生成したポリマーを溶媒でリパルプしたり、リンスすることにより、ポリマーに付着している残存モノマーや低分子量オリゴマーなどを効率よく除くことができる。また、ポリマーに対して親和性を有する高沸点溶媒が除去されるためか、後の乾燥工程などにおいてポリマー粒子表面が硬くなったり、ポリマー粒子同士の融着等を防止できる。そのため、ポリマーのレジスト溶剤に対する溶解性が著しく向上し、フォトレジスト用樹脂組成物の調製を簡易に効率よく行



リパルプ処理に用いる溶媒(リパルプ用溶媒)やリンス処理に用いる溶媒(リンス用溶媒)としては、沈殿又は再沈殿に用いるポリマーの貧溶媒が好ましい。なかでも炭化水素溶媒が特に好ましい。炭化水素溶媒としては、例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素が挙げられる。これらは2種以上混合して使用してもよい。これらのなかでも、脂肪族炭化水素、特にヘキサン若しくはヘプタン、又はヘキサン若しくはヘプタンを含む混合溶媒が好適である。

[0062]

[0061]

リパルプ用溶媒の使用量は、ポリマーに対して、例えば $1 \sim 200$ 重量倍、好ましくは $5 \sim 100$ 重量倍程度である。一方、リンス溶媒の使用量は、ポリマーに対して、例えば $1 \sim 100$ 重量倍、好ましくは $2 \sim 20$ 重量倍程度である。リパルプ処理やリンス処理を施す際の温度は、用いる溶媒の種類等によっても異なるが、一般には $0 \sim 100$ で、好ましくは $10 \sim 60$ で程度である。リパルプ処理、リンス処理は適当な容器中で行われる。リパルプ処理、リンス処理はそれぞれ複数回行ってもよい。処理済みの液(リパルプ液、リンス液)は、デカンテーション、濾過等により除去される。

[0063]

沈殿又は再沈殿、又はさらに必要に応じてリパルプ処理、リンス処理を経て得られた湿ポリマーは乾燥処理に付される。乾燥温度は、例えば $20 \sim 120 \, \mathbb{C}$ 、好ましくは $40 \sim 100 \, \mathbb{C}$ 程度である。乾燥は減圧下、例えば $200 \, \mathbb{C}$ mmHg($26.6 \, \mathbb{K}$ Pa)以下、特に $100 \, \mathbb{C}$ mmHg($13.3 \, \mathbb{K}$ Pa)以下で行うのが好ましい。

[0064]

上記方法により、重量平均分子量が3000~15000の範囲であり、且つ分子量40000を超えるポリマーの含有率が4重量%以下であるフォトレジスト用樹脂を得ることができる。なお、重量平均分子量は、単量体組成、重合開始剤の量、重合温度、重合時間等を適宜調整することによりコントロールできる。

[0065]

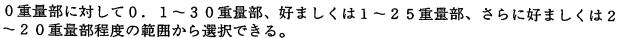
このようにして得られるフォトレジスト用樹脂 1 gを P GME A (プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート) 1 9 gと混合し、室温で 6 0 分間振盪して得られる樹脂濃度 5 重量%の樹脂混合液の濁度 [JIS K 0 1 0 1 (積分球式濁度)に準じる]は、通常 $0 \sim 1$ 0 程度であり、好ましくは $0 \sim 3$ 、さらに好ましくは $0 \sim 1$ (特に $0 \sim 0$. 1) 程度である。

[0066]

本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は本発明のフォトレジスト用樹脂と共に光酸発生剤を含んでいる。光酸発生剤としては、露光により効率よく酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへキサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例えば、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムステル [例えば、1ーフェニルスルホニウムメタンスルホネートなど)、スルホン酸エステル [例えば、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニル)スルホニルオキシー1ーベンゾイルメタン、1,2,3ートリスルホニルオキシメチルベンゼン、1,3ージニトロー2ー(4ーフェニルスルホニルオキシメチル)ベンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル) でンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル) でいていていていていていていていている。

[0067]

光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度やポリマー (フォトレジスト用 樹脂) における各繰り返し単位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、ポリマー10



[0068]

フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など)などのアルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んでいてもよい。

[0069]

本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、本発明のフォトレジスト用樹脂を溶媒(フォトレジスト用の溶剤)に溶解させることにより調製できる。より具体的には、本発明のフォトレジスト用樹脂をそのまま、又は必要に応じて適宜な精製処理を施した後、有機溶媒中に入れ、光酸発生剤などとともに撹拌混合することによりフォトレジスト用樹脂組成物を得ることができる。

[0070]

こうして得られるフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成できる。

[0071]

基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば0.1~20μm、好ましくは0.3~2μm程度である。

[0072]

露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeCl、KrF、KrCl、ArF、ArCl などが使用される。露光エネルギーは、例えば $1\sim1000m$ J $/ cm^2$ 、好ましくは $10\sim500m$ J $/ cm^2$ 程度である。

[0073]

光照射により光酸発生剤から酸が生成し、この酸により、例えばフォトレジスト用樹脂の酸の作用によりアルカリ可溶となる繰り返し単位(酸脱離性基を有する繰り返し単位)のカルボキシル基等の保護基(脱離性基)が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現像により、所定のパターンを精度よく形成できる。

【実施例】

[0074]

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。なお、化合物番号(モノマー番号)の後ろに「アクリレート」とあるのは、明細書中に記載の化合物番号に相当する2つの化合物のうちアクリロイルオキシ基を有する化合物を示し、「メタクリレート」とあるのは、前記2つの化合物のうちメタクリロイルオキシ基を有する化合物を示す。重量平均分子量(Mw)、分子量分布(Mw/Mn)、分子量40000を超えるポリマーの含有率は、検出器として屈折率計(RI)を用い、溶離液としてテトラヒドロフラン(THF)を用いたGPC測定により、標準ポリスチレン換算で求めた。GPC測定は昭和電工(株)製カラム「Shodex KF-806L」(商品名)を3本直列につないだものを使用し、試料濃度0.5%、サンプル注入量35μl、カラム温度40℃、RI温度40℃、溶離液の流速0.8ml/分、分析時間60分の条件で行った。GPC測定装置として、(株)島津製作所製の「GPCLC-10 A」を用いた。

[0075]



下記構造のフォトレジスト用樹脂の製造 【化5】

撹拌機、温度計、還流冷却管、2つの滴下用容器、及び窒素導入管を備えた反応容器に 、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)を2500g仕込 み、77℃に昇温後、1-ヒドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン (HMA) [化合物番号 [2-5] (メタクリレート)] 500g、5-メタクリロイルオキシー2 , 6-ノルボルナンカルボラクトン(MNBL) [化合物番号 [2-10] (メタクリレート)] 500g、及び2-メタクリロイルオキシ-2-メチルアダマンタン (2MMA) [化合物番号 [1-1] (メタクリレート)] 500gを、プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート (PGMEA) 4000gに溶解した単量体溶液と、ジメチルー2, 2′ーアゾビス(2ーメチルプロピオネート)(開始剤;和光純薬工業製、V-601) 93gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA) 900gに 溶解した重合開始剤溶液とを、別々の滴下用容器から、それぞれ定量ポンプを用いて、反 応容器内に6時間かけて滴下した。滴下開始後徐々に温度が下がり始めたところで、制御 系の設定温度を徐々に75℃とし、以後75℃を設定温度とした。液温は滴下開始から1 0分の間に77℃から75℃まで下がった。そして、滴下開始して10分後から6時間後 までは、重合温度(反応の液温)は75℃±1℃以内に制御できた。滴下終了後、2時間 同温度で熟成した。重合液を65000gのヘプタンと21500gの酢酸エチルの混合 溶液中に常温で滴下し、30分撹拌後90分静置した。上澄み液を抜き取り、その残渣に ヘプタン64000gを加えて、常温でリパルプ操作を実施した。この操作は計2回行っ た。上澄み液を抜き取った後の残渣を遠心分離機に移液し、遠心力により脱液を行い、湿 ポリマーを得た。この湿ポリマーに6500gのヘプタンを加え、遠心分離機中でリンス を行い、リンス液を除去した。得られた湿ポリマーを取り出し、20mmHg (2.66 kPa)、50℃にて減圧乾燥し、所望の樹脂を1100g得た。回収した樹脂をGPC 分析したところ、重量平均分子量 (Mw) は9100、分子量分布 (Mw/Mn) は1. 8であった。また、分子量40000を超えるポリマーの含有率は1.2重量%であった

[0076]

実施例2

実施例1と同じ構造のフォトレジスト用樹脂の製造

撹拌機、温度計、還流冷却管、2つの滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)を25g導入し、77℃に昇温後、1-ヒドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン(1MA) [化合物番号 [2-5] (メタクリレート)] 5g、5-メタクリロイルオキシー 2,6-ノルボルナンカルボラクトン(1MNBL) [化合物番号 [2-10] (メタクリレート)] 15g、及び12-メタクリロイルオキシー12-メチルアダマンタン(12-メタクリレート)] 13g、及び12-メタクリレート)] 13gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(14-1)(14-1)(15-1)(15-1)(15-1)(15-1)(15-1)(15-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(16-1)(



[0077]

比較例1

実施例1と同じ構造のフォトレジスト用樹脂の製造

撹拌機、温度計、還流冷却管、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコ に、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) を33g導入し 、 7 5 ℃に昇温後、1ーヒドロキシー3ーメタクリロイルオキシアダマンタン(HMA) [化合物番号 [2-5] (メタクリレート)] 5g、5ーメタクリロイルオキシー2, 6-ノルボルナンカルボラクトン(MNBL) [化合物番号 [2-10] (メタクリレート)] 5 g、2-メタクリロイルオキシー2-メチルアダマンタン($2\,\mathrm{MMA}$) [化合物番号 [1-1] (メタクリレート)] 5gと、ジメチルー2, 2′ーアゾビス(2ーメチルプロピオ ネート)(開始剤;和光純薬工業製、V-601)0.93gと、プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート(PGMEA)41gの混合溶液を、滴下ロートから6時 間かけて滴下した。制御系の設定温度を75℃として温度制御を行ったが、滴下開始時に 液温が大きく下降して70℃未満となり、単量体及び重合開始剤を含む混合溶液の全滴下 時間(6時間)のうち滴下初期の30分間(全滴下時間の8.3%)、重合温度(反応の 液温)の振れ幅が設定温度75℃に対して±5℃の範囲を逸脱していた。なお、滴下開始 後30分以降は75℃±1℃以内に制御できた。滴下終了後、2時間同温度で熟成した。 重合液を650gのヘプタンと215gの酢酸エチルの混合溶液中に常温で滴下し、30 分撹拌後90分静置した。上澄み液を抜き取り、その残渣にヘプタン640gを加えて、 常温でリパルプ操作を実施した。この操作は計2回行った。上澄み液を抜き取った後の残 渣を遠心分離機に移液し、遠心力により脱液を行い、湿ポリマーを得た。この湿ポリマー に65gのヘプタンを加え、遠心分離機中でリンスを行い、リンス液を除去した。得られ た湿ポリマーを取り出し、20mmHg(2.66kPa)、50℃にて減圧乾燥し、所 望の樹脂を10g得た。回収した樹脂をGPC分析したところ、重量平均分子量(Mw) は9700、分子量分布 (Mw/Mn) は3.1であった。また、分子量40000を超 えるポリマーの含有率は4.7重量%であった。

[0078]

評価試験

上記実施例及び比較例で得られた各樹脂について、樹脂1gをPGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)19gと混合し、室温で60分間振盪して、樹脂濃度5重量%の樹脂混合液を調製した。この樹脂混合液の濁度を、濁色計[商品名「NDH 300A」、日本電色工業(株)製]を用い、JIS K 0101(積分球式濁度)に準じて測定した。その結果、実施例1及び2で得られた樹脂の濁度は0.0であり、比較例1で得られた樹脂の濁度は13.3であり、両者に大きな差が認められた。





【書類名】要約書

【要約】

【課題】 レジスト用溶剤に極めて溶解しやすいフォトレジスト用樹脂を得る。

【解決手段】 フォトレジスト用樹脂は、酸によりその一部が脱離してアルカリ可溶性となる基を含む繰り返し単位 A と、極性基を有する脂環式骨格を含む繰り返し単位 B とを少なくとも含有するフォトレジスト用樹脂であって、重量平均分子量が $3000 \sim 1500$ の範囲であり、且つ分子量 40000 を超えるポリマーの含有率が 4 重量%以下であることを特徴とする。樹脂の分子量分布(Mw/Mn)は、例えば $1.1 \sim 3.0$ 、好ましくは $1.5 \sim 2.5$ 程度である。

【選択図】 なし



特願2003-354224

出願人履歷情報

識別番号

[000002901]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

1990年 8月28日 新規登録 大阪府堺市鉄砲町1番地 ダイセル化学工業株式会社